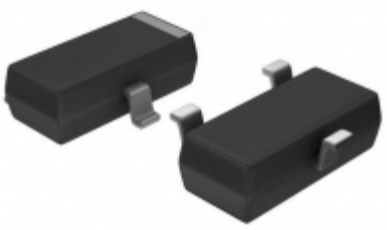

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2304BDS-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3</p>
	<p>Datenblätter:  SI2304BDS-T1-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 93081 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferen von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2304BDS-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	93081 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 2.6A (Ta) 750mW (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	225pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2304BDS-T1-GE3TR

SI2304BDS-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI2304BDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2304BDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2304BDS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2304DDS 89K SI2304DDS 89K</p>	 <p>SI2304CDS-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT23</p>	 <p>SI2304BDS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3</p>	 <p>SI2304BDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3</p>
 <p>SI2304BDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3</p>	 <p>SI2304BDS VISHAY SI2304BDS VISHAY</p>	 <p>SI2304BDS-T1-E3 VISHAY SI2304BDS-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI2304-TP Micro Commercial Components (MCC) N-CHANNEL MOSFET, SOT-23 PACKAGE</p>

heiße Teile

Mehr

SI2302DV	SI2302WCB	SI2303ADS-T1-GE3	SI2303BDS	SI2303BDS-T
SI2303BDS-T1	SI2303BDS-T1	SI2303BDS-T1-E3	SI2303BDS-T1-E3	SI2303BDS-T1-GE3
SI2303BDS-T1-GE3	SI2303BDS/A5	SI2303CDS	SI2303CDS-T1-E3	SI2303CDS-T1-E3
SI2303CDS-T1-GE3	SI2303CDS-T1-GE3	SI2303DL-T1-E3	SI2303DS	SI2303DS-T1
SI2303DS-T1-E3	SI2303DS-T1-GE3	SI2304-TP	SI2304BDS-T1-E3	SI2304BDS-T1-E3
SI2304BDS-T1-GE3	SI2304BDS-T1-E3	SI2304DDS-T1-E3	SI2304DDS-T1-GE3	SI2304DDS-T1-GE3
SI2304DS	SI2304DS-T1	SI2304DS-T1-E3	SI2304DS-T1-GE3	SI2305-CDS-T1-GE3
SI2305ADS-T1-E3	SI2305ADS-T1-E3	SI2305ADS-T1-GE3	SI2305ADS-T1-GE3	SI2305BDS-T1-E3
SI2305BDS-T1-GE3	SI2305CDS-T1-E3	SI2305CDS-T1-GE3	SI2305CDS-T1-GE3	SI2305DS
SI2305DS-E3	SI2305DS-T1	SI2305DS-T1-E3	SI2305DS-T1-E3	SI2305DS-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

